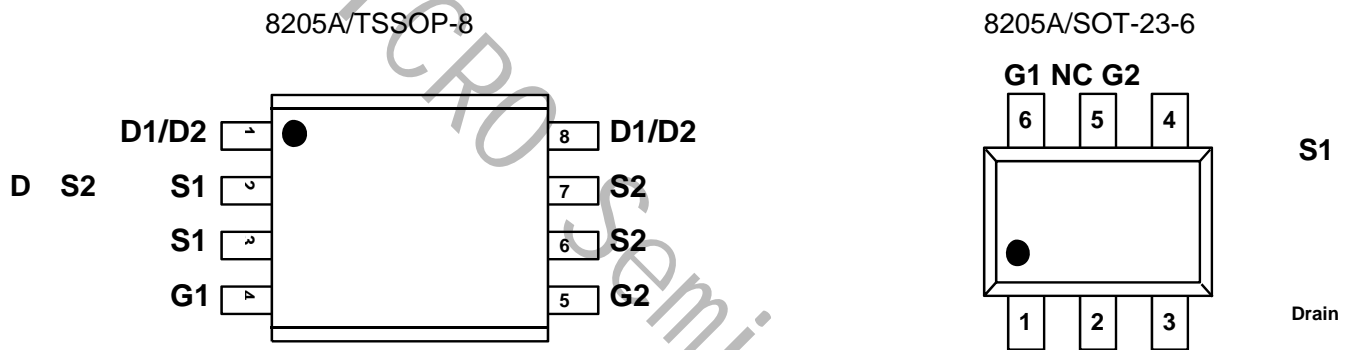
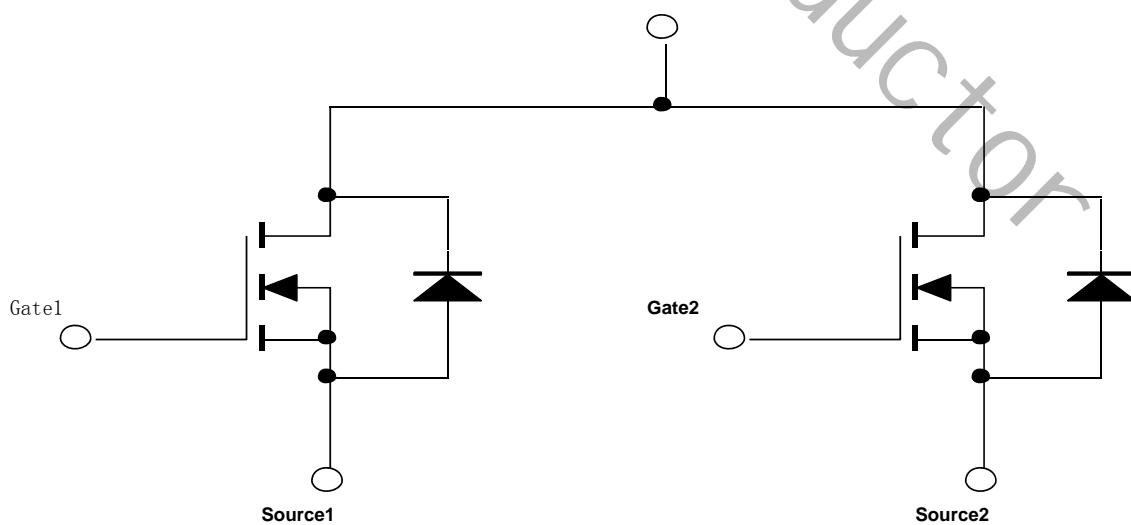


特点

- ◆ 低导通电阻高密度超低电阻设计
- ◆ 2.5V 栅极驱动
- ◆ 低驱动电流
- ◆ 理想的锂电池保护应用
- ◆ 封装形式: TSSOP-8/SOT-23-6



N-Channel MOSFET



最大额定值和热特性 (Ta = 25°C, 除非另有说明。)

| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | |
|----------------|-----------------------------------|------------|------|---|
| 漏源电压 | V _{DS} | 20 | V | |
| 栅源电压 | V _{GS} | ±12 | | |
| 连续漏电流, VS@4.5V | I _D @TA=25°C | 6 | A | |
| 漏极脉冲电流 | I _{DM} | 20 | | |
| 最大功耗 | P _D | TA = 25°C | 2 | W |
| | | TA = 75°C | 1.3 | |
| 工作结温和存储温度范围 | T _J , T _{stg} | -55 to 150 | °C | |
| 结环热阻 (PCB 安装) | R _{θJA} | 62.5 | °C/W | |

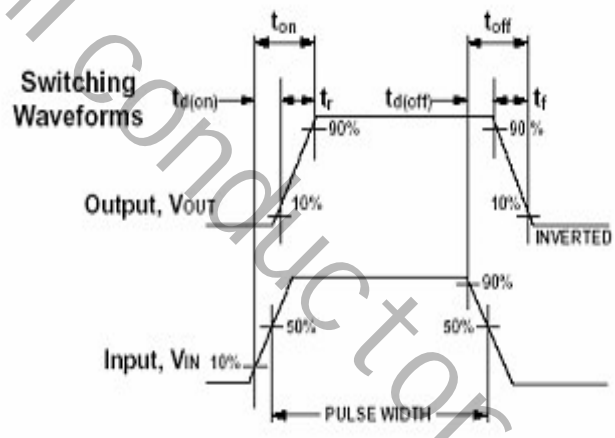
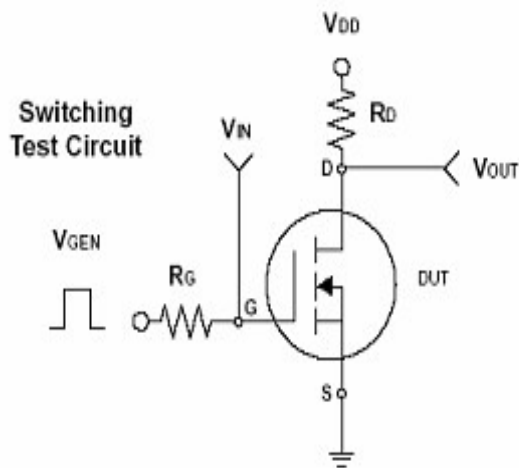
注: 重复性极限值: 脉冲宽度由最高结温限制。

电特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|------------|---------------------|--|-----|------|------|----|
| 静电 | | | | | | |
| 漏源击穿电压 | BV _{DSS} | V _{GS} = 0V, I _D = 250uA | 20 | -- | -- | V |
| 漏源电阻 | R _{DS(on)} | V _{GS} = 1.8V, I _D = 2.0A | -- | 53.0 | 75.0 | mΩ |
| | | V _{GS} = 2.5V, I _D = 3.5A | -- | 30.0 | 38.0 | |
| | | V _{GS} = 4.5V, I _D = 4.5A | -- | 22.0 | 28.0 | |
| 栅极阈值电压 | V _{GS(th)} | V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250uA | 0.5 | -- | 1.5 | V |
| 栅源短路时漏极电流 | I _{DSS} | V _{DS} = 20V, V _{GS} = 0V | -- | -- | 1 | uA |
| 漏极短路时截止栅电流 | I _{GSS} | V _{GS} = ±12V, I _D =0uA | -- | -- | ±100 | nA |
| 跨导 | g _{fs} | V _{DS} = 15V, I _D = 6.0A | -- | 29 | -- | S |
| 动态 | | | | | | |
| 总栅极电荷 | Q _g | V _{DS} = 10V, I _D = 6A | | 6.24 | 8.11 | nC |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----|-------|-------|----|
| 栅源电荷 | Q_{gs} | $V_{GS} = 4.5V$ | | 1.64 | 2.13 | |
| 栅漏电荷 | Q_{gd} | | | 1.34 | 1.74 | |
| 延迟时间 (On) | $t_{d(on)}$ | $V_{DD} = 10V, I_D = 6A$ $I_D = 1A, V_{GS} = 4.5V$ | | 10.4 | 20.8 | ns |
| 上升时间 (On) | t_r | | | 4.4 | 8.8 | |
| 延迟时间 (Off) | $t_{d(off)}$ | | | 27.36 | 54.72 | |
| 下降时间 (Off) | t_f | | | 4.16 | 8.32 | |
| 输入电容 | C_{iss} | $V_{DS} = 8V, V_{GS} = 0V$ $f = 1.0MHz$ | -- | 522.3 | -- | pF |
| 输出电容 | C_{oss} | | -- | 98.48 | -- | |
| 反向传输电容 | C_{rss} | | -- | 74.69 | -- | |
| 漏源二极管 | | | | | | |
| 二极管最大正向电流 | I_S | -- | -- | -- | 1.7 | A |
| 二极管正向电压 | V_{SD} | $I_S = 1.7A, V_{GS} = 0V$ | -- | -- | 1.2 | V |

注：脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [JSMSEMI](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [AOD464](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#)
[405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#) [BSC884N03MS G](#) [BSF024N03LT3 G](#)
[PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-](#)
[7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#)
[SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#)
[C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IRF40SC240ARMA1](#)
[IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)